

IEEE EDS DL-Workshop

-Carrier Trapping, Origin of Device Degradation-

日時：8月26日（水） 14:00～17:30

場所：広島大学先端物質科学研究科 302S 会議室

[プログラム]

1. Tibor Grasser ウィーン大学教授
Recent Progress in Understanding the Bias Temperature
Instability: from Single Traps to Distributions
2. 土屋敏章 島根大学教授
単一 MOS 界面トラップの検出と評価解析
3. 三浦道子 広島大学教授
MOSFET における動的キャリアトラップモデル

トランジスタ劣化問題が再燃している大きな理由として、先端デバイスを用いた回路設計においてマージンに十分にとれなくなったことが挙げられる。劣化の主な原因がキャリアトラップであることは、疑う余地がなくなっている。本ワークショップでは、キャリアトラップを様々な観点から解説する。

参加無料で多くの参加者による活発な意見交換会となることを期待しております。ご質問は mmm@hiroshima-u.ac.jp までお寄せください。